

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)公開番号
特開2023-170262
(P2023-170262A)

(43)公開日 令和5年12月1日(2023.12.1)

(51)国際特許分類		F I		テーマコード (参考)	
B 2 4 B	37/005 (2012.01)	B 2 4 B	37/005	A	3 C 0 3 4
B 2 4 B	37/30 (2012.01)	B 2 4 B	37/30	E	3 C 1 5 8
B 2 4 B	37/013 (2012.01)	B 2 4 B	37/013		5 F 0 5 7
B 2 4 B	41/06 (2012.01)	B 2 4 B	41/06	A	
B 2 4 B	49/12 (2006.01)	B 2 4 B	49/12		
審査請求 未請求 請求項の数 11 O L (全24頁) 最終頁に続く					
(21)出願番号	特願2022-81873(P2022-81873)		(71)出願人	000000239	
(22)出願日	令和4年5月18日(2022.5.18)			株式会社荏原製作所	
				東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号	
			(74)代理人	100106208	
				弁理士 宮前 徹	
			(74)代理人	100146710	
				弁理士 鐘ヶ江 幸男	
			(74)代理人	100186613	
				弁理士 渡邊 誠	
			(74)代理人	100172041	
				弁理士 小畑 統照	
			(72)発明者	斎藤 歩	
				東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式	
				会社荏原製作所内	
			F ターム (参考)	3C034 AA07 BB71 BB83 BB93	
				最終頁に続く	

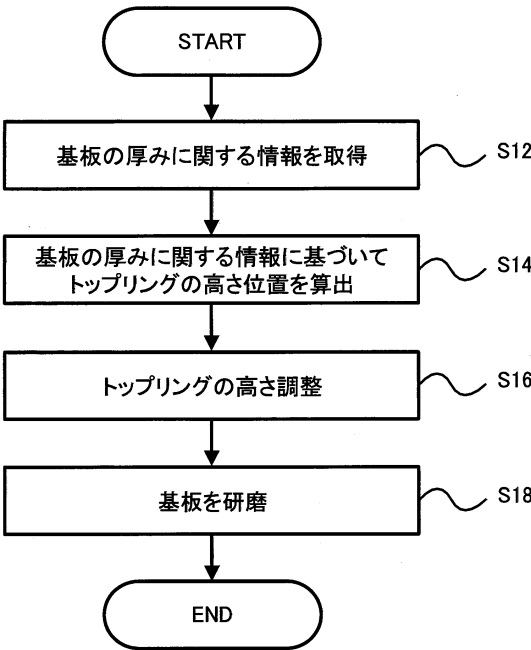
(54)【発明の名称】 基板研磨方法、プログラム、および、基板研磨装置

(57)【要約】

【課題】様々な寸法の基板に対応して研磨を行うための基板研磨方法などを提案する。

【解決手段】研磨面を有した研磨テーブルと、基板を保持して前記研磨面に押圧するためのトップリングと、前記トップリングを上下動させる上下動機構と、を備えた研磨装置による基板研磨方法が提案される。当該方法は、前記基板の厚みに関する情報を取得する取得ステップと、取得した前記基板の厚みに関する情報に基づいて前記研磨テーブルに対する前記トップリングの高さ位置を調整する位置調整ステップと、トップリングの圧力室に圧力流体を供給して前記基板を前記研磨面に押圧することにより前記基板を研磨する研磨ステップと、を含む。

【選択図】図 1 1



10

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

研磨面を有した研磨テーブルと、基板を保持して前記研磨面に押圧するためのトップリングと、前記トップリングを上下動させる上下動機構と、基板の厚みに関する情報を取得するためのセンサと、を備えた研磨装置による基板研磨方法であって、

前記トップリングは、圧力流体が供給される圧力室を形成する弾性膜であるメンブレンと当該メンブレンを保持するトップリング本体とを有し、前記圧力室に圧力流体を供給することで前記基板を前記研磨面に押圧するように構成され、

前記基板研磨方法は、

前記センサにより前記基板の厚みに関する情報を取得する取得ステップと、

10

取得した前記基板の厚みに関する情報に基づいて前記研磨テーブルに対する前記トップリングの高さ位置を調整する位置調整ステップと、

前記圧力室に圧力流体を供給して前記基板を前記研磨面に押圧することにより、前記基板を研磨する研磨ステップと、

を含む、基板研磨方法。

【請求項 2】

前記取得ステップは、前記基板を保持した前記トップリングと前記研磨テーブルとを接触させることによって行われる、請求項 1 に記載の基板研磨方法。

【請求項 3】

前記研磨装置は、前記研磨テーブルを回転させるための研磨テーブル回転機構を備え、

20

前記取得ステップは、前記研磨テーブルが回転していない状態で行われる、

請求項 2 に記載の基板研磨方法。

【請求項 4】

前記研磨装置は、前記基板を前記トップリングとの間で受け渡しするプッシャを備え、

前記取得ステップは、前記プッシャから前記トップリングに前記基板が受け渡されるときに行われる、

請求項 1 に記載の基板研磨方法。

【請求項 5】

前記取得ステップは、前記プッシャが前記基板を前記トップリングに受け渡すために移動させた距離に基づいて前記基板の厚みに関する情報を取得する、請求項 4 に記載の基板研磨方法。

30

【請求項 6】

前記研磨装置は、前記基板を搬送するように構成されたロードユニット又は搬送ユニットを備え、

前記取得ステップは、前記ロードユニット又は搬送ユニットに設けられたセンサによって前記基板の厚みに関する情報を取得する、

請求項 1 に記載の基板研磨方法。

【請求項 7】

前記研磨装置は、前記基板を搬送するための搬送ユニットを有する処理ラインを備え、

前記取得ステップ、前記位置調整ステップ、および前記研磨ステップは、前記処理ラインから前記基板を搬出することなく行われる、請求項 1 から 6 の何れか 1 項に記載の基板研磨方法。

40

【請求項 8】

前記取得ステップは、前記研磨装置への外部入力により行われる、請求項 1 に記載の基板研磨方法。

【請求項 9】

前記研磨ステップの後に、前記取得ステップで取得した前記基板の厚みに関する情報と前記研磨ステップによる前記基板の研磨量とに基づいて、第 2 の研磨テーブルに対する第 2 のトップリングの高さ位置を調整する第 2 の位置調整ステップと、

前記基板を前記第 2 の研磨テーブルの研磨面に押圧することにより前記基板を研磨する

50

第 2 の研磨ステップと、

を含む、請求項 1 から 6 の何れか 1 項に記載の基板研磨方法。

【請求項 1 0】

基板の処理面に研磨処理を行う制御処理を、研磨装置の処理装置に行わせるためのプログラムであって、

前記研磨装置は、研磨面を有した研磨テーブルと、基板を保持して前記研磨面に押圧するためのトップリングと、前記トップリングを上下動させる上下動機構と、基板の厚みに関する情報を取得するためのセンサと、を備え、

前記トップリングは、圧力流体が供給される圧力室を形成する弾性膜であるメンブレンと当該メンブレンを保持するトップリング本体とを有し、前記圧力室に圧力流体を供給することで前記基板を前記研磨面に押圧するように構成され、

前記制御処理は、

前記センサにより前記基板の厚みに関する情報を取得する取得ステップと、

取得した前記基板の厚みに関する情報に基づいて前記研磨テーブルに対する前記トップリングの高さ位置を調整する位置調整ステップと、

前記圧力室に圧力流体を供給して前記基板を前記研磨面に押圧することにより、前記基板を研磨する研磨ステップと、

を含む、プログラム。

【請求項 1 1】

研磨面を有した研磨テーブルと、

基板を保持して前記研磨面に押圧するためのトップリングであって、圧力流体が供給される圧力室を形成する弾性膜であるメンブレンと、当該メンブレンを保持するトップリング本体と、を有し、前記圧力室に圧力流体を供給することで前記基板を前記研磨面に押圧するように構成されたトップリングと、

前記トップリングを上下動させる上下動機構と、

基板の厚みに関する情報を取得するためのセンサと、

前記センサにより取得された前記基板の厚みに関する情報に基づいて前記研磨テーブルに対する前記トップリングの高さ位置を調整し、前記圧力室に圧力流体を供給して前記基板を前記研磨面に押圧することにより前記基板を研磨するように構成された制御装置と、

を備える、基板研磨装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0 0 0 1】

本願は、基板研磨方法、プログラム、および、基板研磨装置に関する。

【背景技術】

【0 0 0 2】

半導体デバイスの製造に、基板の表面を平坦化するために化学機械研磨（CMP）装置が使用されている。半導体デバイスの製造に使用される基板は、多くの場合、円板形状である。また、半導体デバイスに限らず、CCL基板（Copper Clad Laminate基板）やPCB（Printed Circuit Board）基板、フォトマスク基板、ディスプレイパネルなどの四角形の基板の表面を平坦化する際の平坦度の要求も高まっている。また、PCB基板などの電子デバイスが配置されたパッケージ基板の表面を平坦化することへの要求も高まっている。

【0 0 0 3】

基板研磨装置における基板保持装置として、チャッキングプレートに弾性膜（メンブレン）を固定し、チャッキングプレートの上部に形成される圧力室（加圧チャンバ）、および弾性膜（メンブレン）から形成される圧力室に空気などの流体を供給することで弾性膜を介して流体圧により半導体ウエハを研磨パッドに押圧するタイプのいわゆるフローティング型トップリングが広く用いられている。また、こうした基板保持装置としては、メンブレンを支持するキャリア（トップリング本体）を上下動させる上下動機構を備えるもの

が知られている。上下動機構によってトップリング本体の研磨テーブルに対する位置を調整し、その後にメンブレン内の圧力を調整することで、所望の研磨プロファイルとなるよう研磨が行われる。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特開2003-103458号公報

【特許文献2】特開2014-176950号公報

【特許文献3】特開2010-46756号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

半導体基板は、一般に、規格（たとえばSEMI規格）により寸法が定まっている。しかし、上述のCCL基板やPCB基板、フォトリソマスク基板、ディスプレイパネルなどの基板は、寸法規格がない場合が多く、様々な寸法の基板が存在し得る。上述したような基板保持装置によって基板を保持する際には、基板の寸法が異なると基板と研磨テーブルとの位置関係が変化する。特に、基板の厚みが異なる場合には、研磨テーブルの研磨面と基板の被研磨面との位置関係が変化し、基板保持装置の制御、または、研磨プロファイルに悪影響を与える場合があった。

【0006】

以上の実情に鑑みて、本願は、様々な寸法の基板に対応して研磨を行うための基板研磨方法、プログラム、または、基板研磨装置を提案することを1つの目的としている。

【課題を解決するための手段】

【0007】

一実施形態によれば、研磨面を有した研磨テーブルと、基板を保持して前記研磨面に押圧するためのトップリングと、前記トップリングを上下動させる上下動機構と、基板の厚みに関する情報を取得するためのセンサと、を備えた研磨装置による基板研磨方法が提案され、前記トップリングは、圧力流体が供給される圧力室を形成する弾性膜であるメンブレンと当該メンブレンを保持するトップリング本体とを有し、前記圧力室に圧力流体を供給することで前記基板を前記研磨面に押圧するように構成され、前記基板研磨方法は、前記センサにより前記基板の厚みに関する情報を取得する取得ステップと、取得した前記基板の厚みに関する情報に基づいて前記研磨テーブルに対する前記トップリングの高さ位置を調整する位置調整ステップと、前記圧力室に圧力流体を供給して前記基板を前記研磨面に押圧することにより、前記基板を研磨する研磨ステップと、を含む。

【0008】

別の一実施形態によれば、基板の処理面に研磨処理を行う制御処理を、研磨装置の処理装置に行わせるためのプログラムが提案され、前記研磨装置は、研磨面を有した研磨テーブルと、基板を保持して前記研磨面に押圧するためのトップリングと、前記トップリングを上下動させる上下動機構と、基板の厚みに関する情報を取得するためのセンサと、を備え、前記トップリングは、圧力流体が供給される圧力室を形成する弾性膜であるメンブレンと当該メンブレンを保持するトップリング本体とを有し、前記圧力室に圧力流体を供給することで前記基板を前記研磨面に押圧するように構成され、前記制御処理は、前記センサにより前記基板の厚みに関する情報を取得する取得ステップと、取得した前記基板の厚みに関する情報に基づいて前記研磨テーブルに対する前記トップリングの高さ位置を調整する位置調整ステップと、前記圧力室に圧力流体を供給して前記基板を前記研磨面に押圧することにより、前記基板を研磨する研磨ステップと、を含む。

【0009】

別の一実施形態によれば、基板研磨装置が提案され、かかる基板研磨装置は、研磨面を有した研磨テーブルと、基板を保持して前記研磨面に押圧するためのトップリングであって、圧力流体が供給される圧力室を形成する弾性膜であるメンブレンと、当該メンブレン

10

20

30

40

50

を保持するトップリング本体と、を有し、前記圧力室に圧力流体を供給することで前記基板を前記研磨面に押圧するように構成されたトップリングと、前記トップリングを上下動させる上下動機構と、基板の厚みに関する情報を取得するためのセンサと、前記センサにより取得された前記基板の厚みに関する情報に基づいて前記研磨テーブルに対する前記トップリングの高さ位置を調整し、前記圧力室に圧力流体を供給して前記基板を前記研磨面に押圧することにより前記基板を研磨するように構成された制御装置と、を備える。

【図面の簡単な説明】

【0010】

【図1】一実施形態による基板研磨装置の全体構成を示す平面図である。

【図2】一実施形態によるロードユニットを模式的に示す側面図である。

10

【図3】一実施形態によるロードユニットにおける搬送機構を示す斜視図である。

【図4】一実施形態による搬送ユニットを模式的に示す側面図である。

【図5】一実施形態によるブッシャを示す斜視図である。

【図6】図5に示されるブッシャを矢印6の方に見た部分断面図である。

【図7】第1ステージおよび第2ステージが上位置にあるときを示す部分断面図である。

【図8】第1ステージおよび第2ステージが上位置にあり、さらに第2ステージが、第1ステージに対して上昇した位置にあるときを示す部分断面図である。

【図9】一実施形態による研磨ユニットを概略的に示す斜視図である。

【図10】基板を保持して研磨テーブル上の研磨面に押圧する研磨ヘッドを構成するトップリングの一例を示す断面図である。

20

【図11】一実施形態による基板研磨方法を示すフローチャートである。

【図12】一実施形態による、基板の厚みが比較的小さい場合のトップリングと研磨パッドとを示す断面図である。

【図13】一実施形態による、基板の厚みが比較的大きい場合のトップリングと研磨パッドとを示す断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0011】

以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。以下で説明する図面において、同一または相当する構成要素には、同一の符号を付して重複した説明を省略する。

【0012】

30

図1は、一実施形態による基板研磨装置1000の全体構成を示す平面図である。図1に示される基板研磨装置1000は、ロードユニット100、搬送ユニット200、研磨ユニット300、乾燥ユニット500、およびアンロードユニット600を有する。図示の実施形態において、搬送ユニット200は、2つの搬送ユニット200A、200Bを有し、研磨ユニット300は、2つの研磨ユニット300A、300Bを有する。なお、搬送ユニット200および研磨ユニット300は、1つ又は3つ以上が設けられてもよい。一実施形態において、これらの各ユニットは、独立に形成することができる。これらのユニットを独立して形成することで、各ユニットの数を任意に組み合わせることで異なる構成の基板研磨装置1000を簡易に形成することができる。また、基板研磨装置1000は、制御装置900を備え、基板研磨装置1000の各構成要素は制御装置900により制御される。一実施形態において、制御装置900は、入出力装置、演算装置、記憶装置（記憶媒体）900aなどを備える一般的なコンピュータから構成することができる。制御装置900は、基板研磨装置1000を制御する動作の主体として機能する。制御装置900は、記憶装置900a等に記憶されたプログラムを読み込んで実行することにより各種処理を行う。プログラムは、DVD-ROM等の記録媒体に記録されたものを取得するか、またはネットワークを介して取得されてもよい。

40

【0013】

<ロードユニット>

ロードユニット100は、研磨および洗浄などの処理が行われる前の基板WFを基板研磨装置1000内へ導入するためのユニットである。図2は、一実施形態によるロードユ

50

ニット 100 を模式的に示す側面図である。一実施形態において、ロードユニット 100 は筐体 102 を備える。筐体 102 は基板 WF を受け入れる側に入口開口 104 を備える。図 2 に示される実施形態においては、右側が入口側である。ロードユニット 100 は、入口開口 104 から処理対象である基板 WF を受け入れる。ロードユニット 100 の上流（図 2 では右側）には、本開示による基板研磨装置 1000 による基板 WF の処理より前の処理工程が実施される処理装置が配置される。図 2 に示される実施形態において、ロードユニット 100 は、ID リーダー 106 を備える。ID リーダー 106 は、入口開口 104 から受け入れられた基板の ID を読み取る。基板研磨装置 1000 は、読み取った ID に応じて、基板 WF に対して各種処理を行う。一実施形態において、ID リーダー 106 はなくてもよい。一実施形態において、ロードユニット 100 は、S M E M A (Surface Mount Equipment Manufacturers Association) の機械装置インタフェー規格 (IPC-SMEMA-9851) に準拠するように構成される。

【0014】

図 2 に示される実施形態において、ロードユニット 100 は、基板 WF を搬送するための複数の搬送ローラ 202 を備えている。搬送ローラ 202 を回転させることで、搬送ローラ 202 上の基板 WF を所定の方向（図 2 においては左方向）に搬送することができる。図示の実施形態において、ロードユニット 100 の筐体 102 は、基板 WF の出口開口 108 を有する。ロードユニット 100 は、搬送ローラ 202 上の所定の位置における基板 WF の存在の有無を検知するためのセンサ 112 を有する。センサ 112 は任意の形式のセンサとすることができ、たとえば光学式のセンサとすることができ、図 2 に示される実施形態においては、センサ 112 は筐体 102 内に 2 つ設けられており、1 つは入口開口 104 付近に設けられるセンサ 112 a であり、もう 1 つは出口開口 108 付近に設けられるセンサ 112 b である。一実施形態において、これらのセンサ 112 による基板 WF の検知に応じて、ロードユニット 100 の動作を制御することができる。たとえば、入口開口 104 付近のセンサ 112 a が基板 WF の存在を検知したら、ロードユニット 100 内の搬送ローラ 202 の回転を開始するようにしてもよいし、また、搬送ローラ 202 の回転速度を変更してもよい。また、出口開口 108 付近のセンサ 112 b が基板 WF の存在を検知したら、後続のユニットである搬送ユニット 200 A の入口シャッタ 218 を開くようにしてもよい。また、一実施形態において、ロードユニット 100 は、搬送ローラ 202 によって搬送される基板 WF の厚みを検知するためのセンサ 260 を有する。センサ 260 は任意の形式のセンサとすることができ、たとえば光学式などの測距センサとすることができ、なお、センサ 260 は、ロードユニット 100 に設けられるものに限定されず、これに代えて、または加えて、搬送ユニット 200 に設けられて、搬送ユニット 200 の搬送ローラ 202 上の基板 WF の厚みを検知するものとしてもよい。

【0015】

図 3 は、一実施形態による、ロードユニット 100 における搬送機構を示す斜視図である。図示の実施形態において、ロードユニット 100 の搬送機構は、複数の搬送ローラ 202 と、搬送ローラ 202 が取り付けられる複数のローラシャフト 204 とを有する。図示の実施形態においては、各ローラシャフト 204 には 3 つの搬送ローラ 202 が取り付けられている。基板 WF は、搬送ローラ 202 上に配置され、搬送ローラ 202 が回転することで基板 WF が搬送される。ローラシャフト 204 上の搬送ローラ 202 の取り付け位置は、基板 WF を安定的に搬送することができる位置であれば任意とすることができ、ただし、搬送ローラ 202 は基板 WF に接触するので、処理対象である基板 WF に接触しても問題の無い領域に搬送ローラ 202 が接触するように配置すべきである。一実施形態において、ロードユニット 100 の搬送ローラ 202 は、導電性ポリマーから構成することができる。一実施形態において、搬送ローラ 202 は、ローラシャフト 204 などを介して電氣的に接地される。これは、基板 WF が帯電して基板 WF を損傷することを防止するためである。また、一実施形態において、ロードユニット 100 に、基板 WF の帯電を防止するためにイオナイザー（図示せず）を設けてもよい。また、一実施形態において、基板 WF の厚みを検知するためのセンサ 260 は、搬送ローラ 202 によって搬送され

る基板WFの中央（搬送方向に垂直な方向における中央）またはその近傍を検知するように配置される。なお、センサ260は、基板WFの中央を検知するものに限定されず、任意の場所を検知してもよい。また、センサ260は、一例として、搬送方向に垂直な方向において複数の箇所を検知するように複数のセンサが設けられてもよいし、センサを搬送方向に垂直な方向に移動させる駆動機構が設けられるものとしてもよい。

【0016】

図3に示される実施形態において、ローラシャフト204は、ギア206を介してモータ208により回転駆動される。一実施形態において、モータ208は、サーボモータとすることができる。サーボモータを使用することで、ローラシャフト204および搬送ローラ202の回転速度、つまり基板WFの搬送速度を制御することができる。また、一実施形態において、ギア206は、マグネットギアとすることができる。マグネットギアは非接触式の動力伝達機構なので、接触式のギアのように摩耗による微粒子の発生が生じず、また、給油などのメンテナンスも不要になる。

【0017】

図2、図3に示されるように、ロードユニット100は、入口開口104および出口開口108の付近に、補助ローラ214が設けられている。補助ローラ214は、搬送ローラ202と同程度の高さに配置される。補助ローラ214の位置は、搬送する基板WFの寸法に応じて変更することができる。補助ローラ214は、ユニットと他のユニットとの間に搬送中の基板WFが落ちないように基板WFを支持する。補助ローラ214は、動力源に接続されておらず、自由に回転可能に構成される。

【0018】

一実施形態において、ロードユニット100は、受け入れた基板WFを反転させるための反転機（図示せず）を備えてもよい。一例として、上流の処理装置の仕様により基板WFのパターン領域が形成されている面が上面となるようにロードユニット100に搬送された場合は、反転機により基板WFを反転させて、基板WFのパターン領域が形成されている面が下面となるようにしてから、基板研磨装置1000の後続の処理を行うようにしてもよい。

【0019】

<搬送ユニット>

図4は一実施形態による、搬送ユニット200を模式的に示す側面図である。図1に示される基板研磨装置1000は、2つの搬送ユニット200A、200Bを備えている。2つの搬送ユニット200A、200Bは同一の構成とすることができるので、以下において、一括して搬送ユニット200として説明する。搬送ユニット200は、基板WFを搬送するための複数の搬送ローラ202を備えている。搬送ローラ202を回転させることで、搬送ローラ202上の基板WFを所定の方向に搬送することができる。搬送ユニット200の搬送ローラ202は、導電性ポリマーから形成されても、導電性のないポリマーから形成されてもよい。搬送ローラ202は、上述のロードユニット100の搬送機構と同様に、ローラシャフト204（図4では不図示）に取り付けられており、ギア206を介して、モータ208により駆動される。一実施形態において、モータ208はサーボモータとすることができ、ギア206は、歯車式とすることができるが、ロードユニット100と同様にマグネットギアとすることもできる。また、図示の搬送ユニット200は、ロードユニット100と同様に、搬送中の基板WFの側面を支持するガイドローラ212（図4では不図示）を備える。図示の搬送ユニット200は、搬送ローラ202上の所定の位置における基板WFの存在の有無を検知するためのセンサ216を有する。センサ216は任意の形式のセンサとすることができ、たとえば光学式のセンサとすることができる。図4に示される実施形態においては、センサ216は搬送ユニット200に7個（216a～216g）設けられている。一実施形態において、これらのセンサ216a～216gによる基板WFの検知に応じて、搬送ユニット200の動作を制御することができる。ただし、センサ216の数および配置は、図4に示される例に限定されるものではない。搬送ユニット200は、搬送ユニット200内に基板WFを受け入れるために開閉

10

20

30

40

50

可能な入口シャッタ 218 を有する。なお、一実施形態において、搬送ユニット 200 は、ロードユニット 100 と同様に、基板 WF が搬送方向に隣接する搬送ローラ 202 の間の隙間に潜り込むことを防止する支持部材（図 4 では不図示）と搬送される基板 WF の幅方向両側に関して基板 WF を支持するための複数のガイドローラ 212（図 4 では不図示）も配置されている。

【0020】

図 4 に示されるように、搬送ユニット 200 は、ストッパ 220 を有する。ストッパ 220 は、ストッパ移動機構 222 に接続されており、ストッパ 220 は搬送ローラ 202 上を移動する基板 WF の搬送経路内に進入可能である。ストッパ 220 が基板 WF の搬送経路内に位置しているときは、搬送ローラ 202 上を移動する基板 WF の側面がストッパ 220 に接触し、移動中の基板 WF をストッパ 220 の位置で停止させることができる。また、ストッパ 220 が基板 WF の搬送経路から退避した位置にあるときは、基板 WF は、搬送ローラ 202 上を移動することができる。ストッパ 220 による基板 WF の停止位置は、後述のプッシャ 230 が搬送ローラ 202 上の基板 WF を受け取るることができる位置（基板受け渡し位置）である。

10

【0021】

図 4 中に破線で示されるように、搬送ユニット 200 はプッシャ 230 を有する。プッシャ 230 は、複数の搬送ローラ 202 の上にある基板 WF を、複数の搬送ローラ 202 から離れるように持ち上げることができるように構成される。またプッシャ 230 は、保持している基板 WF を搬送ユニット 200 の搬送ローラ 202 に受け渡すことができるように構成される。

20

【0022】

図 5 は、一実施形態によるプッシャ 230 を示す斜視図である。図 6 は、図 5 に示されるプッシャ 230 を矢印 6 の方に見た部分断面図である。図 6 は、プッシャ 230 とともに、搬送ローラ 202、搬送ローラ 202 上の基板受け渡し位置に配置された基板 WF、および基板 WF を受け取るトップリング 302 を概略的に示している。図 5、6 に示される実施形態において、プッシャ 230 は、第 1 ステージ 232 および第 2 ステージ 270 を備える。第 1 ステージ 232 は、基板 WF をプッシャ 230 から後述するトップリング 302 に受け渡す時に、トップリング 302 のリテーナ部材 3 を支持するためのステージである。第 1 ステージ 232 は、複数の支持柱 234 を備える。図 5 に示されるように、支持柱 234 の端部はトップリング 302 のリテーナ部材 3 を支持する平坦な支持面 234a、およびトップリング 302 を案内するための傾斜面 234b を備える。一実施形態において、複数の支持柱 234 のうちの 4 つの角部にある支持柱 234 が支持面 234a および傾斜面 234b を備えるようにしてもよい。4 つの角部の支持柱 234 により形成される凹部でリテーナ部材 3 を位置合わせできる。4 つの角部以外の支持柱 234 は支持面 234a のみを備えていてもよい。各支持柱 234 の他方の端部は、共通のベース 236 に連結されている。また、各支持柱 234 は、搬送ローラ 202 に干渉しない位置に設けられ、図 5 に示される実施形態においては、各支持柱 234 は、搬送ローラ 202 の間に配置されている。第 2 ステージ 270 は、搬送ローラ 202 上の基板 WF を受け取るように構成される。第 2 ステージ 270 は、複数の支持柱 272 を備える。支持柱 272 の端部は、基板 WF を支持する平坦な支持面を備える。各支持柱 272 の他方の端部は共通のベース 274 に連結されている。また、各支持柱 272 は、搬送ローラ 202 に干渉しない位置に設けられ、図 6 に示される実施形態においては、各支持柱 272 は、搬送ローラ 202 の間に配置されている。第 1 ステージ 232 および第 2 ステージ 270 は、以下で詳述するように、それぞれ昇降機構に連結されており、それぞれ高さ方向（z 方向）に移動可能である。

30

40

【0023】

第 1 ステージ 232 は、高さ方向（z 方向）に移動可能に構成される。一実施形態において、プッシャ 230 は第 1 昇降機構 231 を有する。一実施形態において、図 5、6 に示されるように、プッシャ 230 の第 1 昇降機構 231 は、空圧式の昇降機構であり、シ

50

リンダ 2 4 0 およびピストン 2 4 2 を備える。ピストン 2 4 2 の端部は、可動台座 2 4 4 に連結されている。シリンダ 2 4 0 は、固定台座 2 4 6 に連結されている。固定台座 2 4 6 は、搬送ユニット 2 0 0 の全体を覆う筐体 2 0 1 または搬送ユニット 2 0 0 を設置する床面などに固定される。シリンダ 2 4 0 内の空気圧を調整することにより、ピストン 2 4 2 が移動し、可動台座 2 4 4 を高さ方向（z 方向）に移動させることができる。可動台座 2 4 4 が高さ方向に移動することで、第 1 ステージ 2 3 2 および第 2 ステージ 2 7 0 が高さ方向に移動することができる。図示の実施形態において、可動台座 2 4 4 の上には、第 1 ステージ 2 3 2 および第 2 ステージ 2 7 0 を水平面内で移動させることが可能な X Y ステージ 2 4 8 が搭載されている。X Y ステージ 2 4 8 は、直動ガイドなどにより直交する 2 方向に移動可能に構成される公知の X Y ステージとすることができる。図示の実施形態において、X Y ステージ 2 4 8 の上には、回転ステージ 2 5 0 が搭載されている。回転ステージ 2 5 0 は、X Y 平面（水平面）において回転可能に構成される。換言すれば、回転ステージ 2 5 0 は z 軸を中心に回転可能に構成される。回転ステージ 2 5 0 は、回転軸受などで構成される公知の回転ステージ 2 5 0 を採用することができる。回転ステージ 2 5 0 の上には、第 2 昇降機構 2 3 3 が搭載されている。第 2 昇降機構 2 3 3 は、シリンダ 2 5 2 およびピストン 2 5 4 を有する。シリンダ 2 5 2 は第 1 ステージ 2 3 2 のベース 2 3 6 が連結されている。また、シリンダ 2 5 2 には移動可能なピストン 2 5 4 が連結されており、シリンダ 2 5 2 内の空気圧を調整することで、ピストン 2 5 4 を移動することができる。ピストン 2 5 4 の端部には、第 2 ステージ 2 7 0 のベース 2 7 4 が連結されている。そのため、シリンダ 2 5 2 内の空気圧を調整することで、ピストン 2 5 4 および第 2 ステージ 2 7 0 を高さ方向（z 方向）に移動させることができる。また、上述の構成によれば、第 1 昇降機構 2 3 1 は、第 1 ステージ 2 3 2 および第 2 ステージ 2 7 0 の両方を高さ方向（z 方向）に移動させ、第 2 昇降機構 2 3 3 は、第 2 ステージ 2 7 0 を第 1 ステージ 2 3 2 に対して高さ方向（z 方向）に移動させることができる。また、第 1 ステージ 2 3 2 および第 2 ステージ 2 7 0 は、X Y ステージ 2 4 8 により、水平面内で直交する 2 方向（x y 方向）に移動可能である。さらに、第 1 ステージ 2 3 2 および第 2 ステージ 2 7 0 は、回転ステージ 2 5 0 により、水平面内（z 軸を中心に）で回転可能である。そのため、プッシャ 2 3 0 と後述するトップリング 3 0 2 との間で基板 W F を授受するときに、プッシャ 2 3 0 とトップリング 3 0 2 との位置合わせを行うことができる。なお、図示の実施形態においては、第 1 昇降機構 2 3 1 および第 2 昇降機構 2 3 3 は、空圧式の昇降機構であるが、これらの昇降機構は液圧式でもよく、またモータおよびボールネジなどを使用した電動式の昇降機構としてもよい。

10

20

30

40

【 0 0 2 4 】

第 1 昇降機構 2 3 1 により、第 1 ステージ 2 3 2 および第 2 ステージ 2 7 0 は下位置および上位置の間を移動することができる。図 6 は、第 1 ステージ 2 3 2 および第 2 ステージ 2 7 0 が下位置にあるときを示している。第 1 ステージ 2 3 2 および第 2 ステージ 2 7 0 が下位置にあるときは、図 6 に示されるように第 1 ステージ 2 3 2 の支持柱 2 3 4 の端部および第 2 ステージ 2 7 0 の支持柱 2 7 2 の端部は、搬送ローラ 2 0 2 の基板 W F を支持する面より低い位置にある。図 7 は、第 1 ステージ 2 3 2 および第 2 ステージ 2 7 0 が上位置にあるときを示している。第 1 ステージ 2 3 2 および第 2 ステージ 2 7 0 が上位置にあるときは、第 1 ステージ 2 3 2 の支持柱 2 3 4 の端部および第 2 ステージ 2 7 0 の支持柱 2 7 2 の端部は、搬送ローラ 2 0 2 の基板 W F を支持する面より高い位置にある。すなわち、第 1 ステージ 2 3 2 および第 2 ステージ 2 7 0 が下位置から上位置に移動するときに、搬送ローラ 2 0 2 上に配置された基板 W F を第 2 ステージ 2 7 0 で持ち上げて受け取ることができる。図 8 は、第 1 ステージ 2 3 2 および第 2 ステージ 2 7 0 が上位置にあり、さらに第 2 ステージ 2 7 0 が、第 1 ステージ 2 3 2 に対して上昇した位置にあるときを示している。基板 W F をプッシャ 2 3 0 から後述するトップリング 3 0 2 に受け渡すときは、図 8 に示されるように、基板 W F を保持する第 2 ステージ 2 7 0 を第 1 ステージ 2 3 2 に対して上昇させる。

【 0 0 2 5 】

50

一実施形態において、搬送ユニット 200 には、プッシャ 230 からトップリング 302 に受け渡される基板 W F の厚みを検知するためのセンサ 262 を有する（図 4、図 6 ~ 図 8 参照）。センサ 262 は任意の形式のセンサとすることができ、たとえば光学式などの測距センサを採用することができる。センサ 262 によって取得された情報は制御装置 900 に送られる。図 6 ~ 図 8 に示す例では、センサ 262 は、筐体 201 に取り付けられた画像センサであり、水平方向に撮影方向が向けられている。制御装置 900 は、センサ 262 によって取得された撮像データに基づいて、基板 W F がプッシャ 230 からトップリング 302 に受け渡されたときの基板 W F を保持する第 2 ステージ 270 の第 1 ステージ 232 に対する移動量 D h を算出する。そして、制御装置 900 は、算出した移動量 D h に基づいて基板 W F の厚みを検出するように構成されている。なお、センサ 262 は、こうした例に限定されず、第 2 ステージ 270 の第 1 ステージ 232 に対する移動量 D h を検出するためのレーザ式センサ、ポテンショメータ、過電流式センサ、加速度センサ、リニアスケール式センサなど、公知の種々のセンサを採用することができる。また、センサ 262 は、筐体 201 に取り付けられるのに代えて、または加えて、プッシャ 230 に搭載されてもよい。さらに、センサ 262 は、複数設けられてもよい。

10

【0026】

図 4 に示される搬送ユニット 200 は、洗浄部を有する。図 4 に示されるように、洗浄部は洗浄ノズル 284 を有する。洗浄ノズル 284 は、搬送ローラ 202 の上側に配置される上洗浄ノズル 284 a と、下側に配置される下洗浄ノズル 284 b とを有する。上洗浄ノズル 284 a および下洗浄ノズル 284 b は、図示しない洗浄液の供給源に接続される。上洗浄ノズル 284 a は、搬送ローラ 202 上を搬送される基板 W F の上面に洗浄液を供給するように構成される。下洗浄ノズル 284 b は、搬送ローラ 202 上を搬送される基板 W F の下面に洗浄液を供給するように構成される。上洗浄ノズル 284 a および下洗浄ノズル 284 b は、搬送ローラ 202 上を搬送される基板 W F の幅と同程度、またはそれ以上の幅を備え、基板 W F が搬送ローラ 202 上を搬送されることで、基板 W F の全面が洗浄されるように構成される。図 4 に示されるように、洗浄部は、搬送ユニット 200 のプッシャ 230 の基板受け渡し場所よりも下流側に位置している。

20

【0027】

図 4 に示されるように、洗浄部において、搬送ローラ 202 の上には押さえローラ 290 が配置されている。また、センサ 216 d は、洗浄部の入口付近に配置されている。一実施形態において、センサ 216 d により基板 W F を検知したら、洗浄ノズル 284 から洗浄液を噴射して基板 W F の洗浄を開始することができる。また、基板 W F の洗浄中は、搬送ローラ 202 の回転数を洗浄用の速度にしてもよい。図 4 の実施形態において、センサ 216 f は洗浄部出口点付近に配置される。一実施形態において、センサ 216 f により基板 W F を検知したら、洗浄ノズル 284 からの洗浄液の噴射を終了することができる。基板 W F の洗浄中は、搬送ローラ 202 および押さえローラ 290 により基板 W F が挟まれて搬送されるので、洗浄液の噴射中であっても基板 W F を安定的に搬送することができる。

30

【0028】

図 4 に示されるように、搬送ユニット 200 は、開閉可能な出口シャッタ 286 を有する。また、搬送ユニット 200 は、出口付近にセンサ 216 g を備える。一実施形態において、センサ 216 g により基板 W F を検知したら、出口シャッタ 286 を開き、次のユニットに基板 W F を搬送するようにしてもよい。一実施形態において、センサ 216 g により基板 W F を検知したら、出口シャッタ 286 を開かずに、搬送ローラ 202 での基板 W F の搬送を停止し、次のユニットの処理を待ち、次のユニットの基板受け入れ準備が整った後に、出口シャッタ 286 を開き、基板 W F を次のユニットへ搬送するようにしてもよい。

40

【0029】

< 研磨ユニット >

図 9 は一実施形態による、研磨ユニット 300 を概略的に示す斜視図である。図 1 に示

50

される基板研磨装置 1000 は、2つの研磨ユニット 300 A、300 B を備えている。2つの研磨ユニット 300 A、300 B は同一の構成とすることができるので、以下において、一括して研磨ユニット 300 として説明する。

【0030】

図 9 に示すように、研磨ユニット 300 は、研磨テーブル 350 と、研磨対象物である基板を保持して研磨テーブル 350 上の研磨面に押圧する研磨ヘッドを構成するトップリング 302 とを備えている。研磨テーブル 350 は、テーブル軸 351 を介してその下方に配置される研磨テーブル回転モータ（図示せず）に連結されており、そのテーブル軸 351 周りに回転可能になっている。研磨テーブル 350 の上面には研磨パッド 352 が貼付されており、研磨パッド 352 の表面 352 a が基板を研磨する研磨面を構成している。

10

【0031】

研磨テーブル 350 の上方には研磨液供給ノズル 354 が設置されており、この研磨液供給ノズル 354 によって研磨テーブル 350 上の研磨パッド 352 上に研磨液が供給されるようになっている。また、図 9 に示されるように、研磨テーブル 350 およびテーブル軸 351 には、研磨液を供給するための通路 353 が設けられている。通路 353 は、研磨テーブル 350 の表面の開口部 355 に連通している。研磨テーブル 350 の開口部 355 に対応する位置において研磨パッド 352 は貫通孔 357 が形成されており、通路 353 を通る研磨液は、研磨テーブル 350 の開口部 355 および研磨パッド 352 の貫通孔 357 から研磨パッド 352 の表面に供給される。なお、研磨テーブル 350 の開口部 355 および研磨パッド 352 の貫通孔 357 は、1つまたは複数でもよいし、設けられなくてもよい。

20

【0032】

トップリング 302 は、トップリングシャフト 18 に接続されており、このトップリングシャフト 18 は、上下動機構 319 により揺動アーム 360 に対して上下動するようになっている。このトップリングシャフト 18 の上下動により、揺動アーム 360 に対してトップリング 302 の全体を上下動させ位置決めするようになっている。トップリングシャフト 18 は、図示しないトップリング回転モータの駆動により回転するようになっている。トップリングシャフト 18 の回転により、トップリング 302 がトップリングシャフト 18 を中心にして回転するようになっている。なお、トップリングシャフト 18 の上端にはロータリージョイント 323 が取り付けられている。

30

【0033】

トップリング 302 は、その下面に基板を保持できるようになっている。揺動アーム 360 は支軸 362 を中心として旋回可能に構成されている。トップリング 302 は、揺動アーム 360 の旋回により、上述の搬送ユニット 200 の基板受け渡し位置と研磨テーブル 350 の上方との間で移動可能である。トップリングシャフト 18 を下降させることで、トップリング 302 を下降させて基板を研磨パッド 352 の表面（研磨面）352 a に押圧することができる。このとき、トップリング 302 および研磨テーブル 350 をそれぞれ回転させ、研磨テーブル 350 の上方に設けられた研磨液供給ノズル 354 から、および/または、研磨テーブル 350 に設けられた開口部 355 から研磨パッド 352 上に研磨液を供給する。このように、基板を研磨パッド 352 の研磨面 352 a に押圧して基板の表面を研磨することができる。

40

【0034】

トップリングシャフト 18 およびトップリング 302 を上下動させる上下動機構 319 は、軸受 321 を介してトップリングシャフト 18 を回転可能に支持するブリッジ 28 と、ブリッジ 28 に取り付けられたボールねじ 32 と、支柱 130 により支持された支持台 29 と、支持台 29 上に設けられた A C サーボモータ 38 とを備えている。サーボモータ 38 を支持する支持台 29 は、支柱 130 を介して揺動アーム 360 に固定されている。

【0035】

ボールねじ 32 は、サーボモータ 38 に連結されたねじ軸 32 a と、このねじ軸 32 a

50

が螺合するナット 3 2 b とを備えている。トップリングシャフト 1 8 は、ブリッジ 2 8 と一体となって上下動するようになっている。したがって、サーボモータ 3 8 を駆動すると、ボールねじ 3 2 を介してブリッジ 2 8 が上下動し、これによりトップリングシャフト 1 8 およびトップリング 3 0 2 が上下動する。研磨ユニット 3 0 0 は、ブリッジ 2 8 の下面までの距離、すなわちブリッジ 2 8 の位置を検出する位置検出部としての測距センサ 7 0 を備えている。この測距センサ 7 0 によりブリッジ 2 8 の位置を検出することで、トップリング 3 0 2 の位置を検出することができるようになっている。測距センサ 7 0 は、ボールねじ 3 2 , サーボモータ 3 8 とともに上下動機構 3 1 9 を構成している。なお、測距センサ 7 0 は、レーザ式センサ、超音波センサ、過電流式センサ、またはリニアスケール式センサであってもよい。また、測距センサ 7 0 、サーボモータ 3 8 をはじめとする研磨ユニット内の各機器は、制御装置 9 0 0 により制御されるように構成される。

10

【 0 0 3 6 】

一実施形態による研磨ユニット 3 0 0 は、研磨パッド 3 5 2 の研磨面 3 5 2 a をドレッシングするドレッシングユニット 3 5 6 を備えている。このドレッシングユニット 3 5 6 は、研磨面 3 5 2 a に摺接されるドレッサ 5 0 と、ドレッサ 5 0 が連結されるドレッサシャフト 5 1 と、ドレッサシャフト 5 1 の上端に設けられたエアシリンダ 5 3 と、ドレッサシャフト 5 1 を回転自在に支持する揺動アーム 5 5 とを備えている。ドレッサ 5 0 の下部はドレッシング部材 5 0 a により構成され、このドレッシング部材 5 0 a の下面には針状のダイヤモンド粒子が付着している。エアシリンダ 5 3 は、支柱 5 6 により支持された支持台 5 7 上に配置されており、これらの支柱 5 6 は揺動アーム 5 5 に固定されている。

20

【 0 0 3 7 】

揺動アーム 5 5 は図示しないモータに駆動されて、支軸 5 8 を中心として回転するように構成されている。ドレッサシャフト 5 1 は、図示しないモータの駆動により回転し、このドレッサシャフト 5 1 の回転により、ドレッサ 5 0 がドレッサシャフト 5 1 周りに回転するようになっている。エアシリンダ 5 3 は、ドレッサシャフト 5 1 を介してドレッサ 5 0 を上下動させ、ドレッサ 5 0 を所定の押圧力で研磨パッド 3 5 2 の研磨面 3 5 2 a に押圧する。

【 0 0 3 8 】

研磨パッド 3 5 2 の研磨面 3 5 2 a のドレッシングは次のようにして行われる。ドレッサ 5 0 はエアシリンダ 5 3 により研磨面 3 5 2 a に押圧され、これと同時に図示しない純水供給ノズルから純水が研磨面 3 5 2 a に供給される。この状態で、ドレッサ 5 0 をドレッサシャフト 5 1 周りに回転させるとともに揺動アーム 5 5 を研磨面 3 5 2 a 上で揺動させ、ドレッシング部材 5 0 a の下面（ダイヤモンド粒子）を回転する研磨面 3 5 2 a に摺接させる。このようにして、ドレッサ 5 0 により研磨パッド 3 5 2 が削り取られ、研磨面 3 5 2 a がドレッシングされる。

30

【 0 0 3 9 】

本実施形態の研磨装置では、このドレッサ 5 0 を利用して研磨パッド 3 5 2 の摩耗量を測定する。すなわち、ドレッシングユニット 3 5 6 はドレッサ 5 0 の変位を測定する変位センサ 6 0 を備えている。この変位センサ 6 0 は、研磨パッド 3 5 2 の摩耗量を検知する摩耗量検知手段を構成し、揺動アーム 5 5 の上面に設けられている。ドレッサシャフト 5 1 にはターゲットプレート 6 1 が固定されており、ドレッサ 5 0 の上下動にともなって、ターゲットプレート 6 1 が上下動するようになっている。変位センサ 6 0 はこのターゲットプレート 6 1 を挿通するように配置されており、ターゲットプレート 6 1 の変位を測定することによりドレッサ 5 0 の変位を測定する。なお、変位センサ 6 0 としては、リニアスケール、レーザ式センサ、超音波センサ、もしくは渦電流式センサなどのあらゆるタイプのセンサが用いられる。

40

【 0 0 4 0 】

本実施形態では、次のようにして研磨パッド 3 5 2 の摩耗量が測定される。まず、エアシリンダ 5 3 を駆動させてドレッサ 5 0 を、初期目立て済の研磨パッド 3 5 2 の研磨面 3 5 2 a に当接させる。この状態で、変位センサ 6 0 はドレッサ 5 0 の初期位置（高さ初期

50

値)を検知し、その初期位置(高さ初期値)を制御装置900に記憶する。そして、1つの、または複数の基板の研磨処理が終了した後、再びドレスサ50を研磨面352aに当接させ、この状態でドレスサ50の位置を測定する。ドレスサ50の位置は研磨パッド352の摩耗量に応じて下方に変位するため、制御装置900は、上記初期位置と研磨後のドレスサ50の位置との差を求めることで、研磨パッド352の摩耗量を求めることができる。このようにして、ドレスサ50の位置に基づいて研磨パッド352の摩耗量が求められる。

【0041】

次に、一実施形態による研磨ユニット300におけるトップリング302について説明する。図10は、一実施形態による、研磨対象物である基板を保持して研磨パッド上の研

10

【0042】

図10に示されるように、トップリング302は、基板WFを研磨面352aに対して押圧するトップリング本体2と、研磨面352aを直接押圧するリテーナ部材3とを有する。トップリング本体2は概略四角形の平板状の部材からなり、リテーナ部材3はトップリング本体2の外周部に取り付けられている。トップリング本体2は、エンジニアリングプラスチック(例えば、PEEK)などの樹脂により形成されている。トップリング本体2の下面には、基板の裏面に接触する弾性膜(メンブレン)4が取り付けられている。一実施形態において、弾性膜(メンブレン)4は、エチレンプロピレンゴム(EPDM)

20

【0043】

弾性膜(メンブレン)4は同心状の複数の隔壁4aを有し、これら隔壁4aによって、弾性膜4の上面とトップリング本体2の下面との間に円形状のセンター室5、センター室5を囲う四角の環状のリブル室6、リブル室6を囲う四角の環状の中間室7、中間室7を囲う四角の環状の OUTER 室8、OUTER 室8を囲う四角の環状のエッジ室9が形成されている。すなわち、トップリング本体2の中心部にセンター室5が形成され、中心から外周方向に向かって、順次、同心状に、リブル室6、中間室7、OUTER 室8、エッジ室9が形成されている。弾性膜4には、リブル室6に連通し基板WFをトップリング302に真空吸着させるための複数の真空吸着孔(図示せず)が形成されている。真空吸着孔は図示しない真空源に連結され、真空吸着孔を介して基板WFをトップリング302の弾性膜4に対して真空吸着させることができる。

30

【0044】

また、リテーナ部材3の上にも弾性膜からなるリテーナ部材加圧室10が形成されている。センター室5、リブル室6、中間室7、OUTER 室8、エッジ室9およびリテーナ部材加圧室10は、流路11~16を介して図示しない圧力調整部に接続されている。このような構造により、基板WFを研磨パッド352に押圧する押圧力を基板WFの領域毎に調整でき、かつリテーナ部材3が研磨パッド352を押圧する押圧力を調整できる。

40

【0045】

<乾燥ユニット>

乾燥ユニットは、基板WFを乾燥させるための装置である。図1に示される基板研磨装置1000においては、乾燥ユニット500は、研磨ユニット300で研磨された後に、搬送ユニット200の洗浄部で洗浄された基板WFを乾燥させる。図1に示されるように、乾燥ユニット500は、搬送ユニット200の下流に配置される。

【0046】

乾燥ユニット500は、搬送ローラ202上を搬送される基板WFに向けて気体を噴射するためのノズル530を有する。気体は、たとえば圧縮された空気または窒素とすることができる。図示の実施形態において、ノズル530は、搬送ローラ202の下側から基

50

板 W F の下面に気体を噴出するように構成された下ノズルと、搬送ローラ 2 0 2 の上側から基板 W F の上面に気体を噴出するように構成されたと、を有してもよい。なお、下ノズルおよび上ノズルは、それぞれ 1 つ設けてもよいし、基板 W F の搬送方向に複数設けてもよい。また、各ノズル 5 3 0 の形式としては気体供給口が基板 W F の幅程度に伸びるスリット状とすることができる。

【 0 0 4 7 】

< アンロードユニット >

アンロードユニット 6 0 0 は、研磨および洗浄などの処理が行われた後の基板 W F を基板研磨装置 1 0 0 0 の外へ搬出するためのユニットである。図 1 に示される基板研磨装置 1 0 0 0 においては、アンロードユニット 6 0 0 は、乾燥ユニット 5 0 0 で乾燥された後の基板を受け入れる。図 1 に示されるように、アンロードユニット 6 0 0 は、乾燥ユニット 5 0 0 の下流に配置される。

10

【 0 0 4 8 】

< 基板研磨方法 >

次に本実施形態における基板研磨装置 1 0 0 0 による基板研磨方法について説明する。図 1 1 は、一実施形態による基板研磨方法を示すフローチャートである。この基板研磨方法は、記憶装置 9 0 0 a 等に記憶されたプログラムを読み込んで制御装置 9 0 0 を主体として実行される。この基板研磨方法は、一例として、ロードユニット 1 0 0 に基板 W F が投入されたときに実行される。

【 0 0 4 9 】

20

< 取得ステップ >

基板研磨方法において、制御装置 9 0 0 は、まず研磨対象である基板 W F の厚みに関する情報を取得する（ステップ S 1 2）。ここで、基板 W F の厚みに関する情報は、一例として、基板 W F の厚み自体であってもよいし、基板 W F の厚みを示す情報であってもよい。以下、基板 W F の厚みに関する情報を「厚み情報」と呼称する場合がある。基板 W F の厚み情報については、一例として、以下に説明する取得ステップの少なくとも 1 つを使用して取得することができる。

【 0 0 5 0 】

< 取得ステップ 1 >

制御装置 9 0 0 は、ロードユニット 1 0 0（または搬送ユニット 2 0 0）に設けられたセンサ 2 6 0 から入力される検出信号に基づいて、基板 W F の厚み情報を取得することができる（図 2、図 3 参照）。この取得ステップでは、搬送ローラ 2 0 2 上の基板 W F の厚みが取得される。センサ 2 6 0 による基板 W F の厚み情報の取得は、搬送ローラ 2 0 2 によって基板 W F を移動させながら行われてもよい。または、搬送ローラ 2 0 2 による搬送を停止させた状態で、センサ 2 6 0 による基板 W F の厚み情報が取得されるものとしてもよい。センサ 2 6 0 は、搬送ローラ 2 0 2 による搬送方向において、基板 W F の複数の箇所を検出してよい。こうした場合には、制御装置 9 0 0 は、基板 W F の複数の箇所の平均値を厚み情報として取得してもよい。

30

【 0 0 5 1 】

< 取得ステップ 2 >

制御装置 9 0 0 は、プッシャ 2 3 0 からトップリング 3 0 2 に基板 W F が受け渡されるときに基板 W F の厚み情報を取得してもよい。制御装置 9 0 0 は、プッシャ 2 3 0 が基板 W F をトップリング 3 0 2 に受け渡すために移動させた距離、具体的な一例としては、第 2 ステージ 2 7 0 の第 1 ステージ 2 3 2 に対する移動量 D h（図 8 参照）に基づいて、基板 W F の厚み情報を取得することができる。具体的な一例として、制御装置 9 0 0 は、搬送ユニット 2 0 0 に設けられたセンサ 2 6 2 から入力される検出信号に基づいて、基板 W F の厚み情報を取得することができる（図 4 ~ 図 8 参照）。

40

【 0 0 5 2 】

< 取得ステップ 3 >

制御装置 9 0 0 は、研磨対象である基板 W F を保持したトップリング 3 0 2 と研磨テー

50

ブル 3 5 0 とを接触させることにより、基板 W F の厚み情報を取得してもよい。この取得ステップは、一例として、トップリング 3 0 2 によるパッドサーチと共に行われるものとしてもよい。ここで、パッドサーチは、研磨パッド 3 5 2 の表面の高さ（位置）を検知する工程である。トップリングによるパッドサーチは、トップリング 3 0 2 の下面を研磨パッド 3 5 2 の表面（研磨面）に接触させたときのトップリング 3 0 2 の高さ位置を検知することにより行われるパッドサーチ時には、サーボモータ 3 8 を駆動して、エンコーダにより回転数を積算しながらトップリング 3 0 2 を下降させる。トップリング 3 0 2 の下面が研磨パッド 3 5 2 の表面に接触すると、サーボモータ 3 8 に対する負荷が増し、サーボモータ 3 8 に流れる電流が大きくなる。したがって、制御装置 9 0 0 の電流検出器によりサーボモータ 3 8 に流れる電流を検出し、電流が大きくなったときに、トップリング 3 0 2 の下面が研磨パッド 3 5 2 の表面に接触したと判断する。トップリング 3 0 2 の下面が研磨パッド 3 5 2 の表面に接触したと判断されると、制御装置 9 0 0 は、サーボモータ 3 8 のエンコーダの積算値から研磨パッド 3 5 2 の表面の高さを得る。こうしたパッドサーチにおいて、制御装置 9 0 0 は、研磨パッド 3 5 2 の表面の高さと共に、基板 W F の厚み情報を取得してもよい。一例として、基板 W F の厚み情報は、トップリング 3 0 2 の下面が研磨パッド 3 5 2 の表面に接触したときの基板 W F と研磨パッド 3 5 2 との距離を検出することにより取得されてもよい。また、別の一例として、基板 W F 表面と研磨パッド 3 5 2 とを接触させることにより、基板 W F の厚み情報が取得されてもよい。このときには、弾性膜（メンブレン）4 の隔壁 4 a の膨らみ量（供給流体量）が考慮されてもよい。さらに、制御装置 9 0 0 は、基板 W F を保持していない状態の参照（基準）高さと、基板 W F を保持した状態の検知高さととの差に基づいて、基板 W F の厚み情報を取得してもよい。つまり一例として、制御装置 9 0 0 は、基板 W F を保持していない状態でトップリング 3 0 2 と研磨テーブル 3 5 0 とを接触させ、そのときのトップリング 3 0 2 の高さ位置を参照高さとして取得する。次に、制御装置 9 0 0 は、基板 W F を保持した状態でトップリング 3 0 2 と研磨テーブル 3 5 0 とを接触させ、そのときのトップリング 3 0 2 の高さ位置を検知高さとして取得する。そして、制御装置 9 0 0 は、取得した参照高さと検知高さの差を基板 W F の厚み情報として取得することができる。また、取得ステップ 3 における基板 W F の厚み情報の取得は、トップリング 3 0 2 に設けられたセンサによる検知に基づいて行われてもよい。一例として、トップリング 3 0 2 は、基板 W F と研磨パッド 3 5 2 との距離を検出するためのセンサ、または、基板 W F と研磨パッド 3 5 2 とが接触したときの弾性膜 4 の膨らみ量を検出するためのセンサとして、リテーナ部材 3 に設けられたセンサ 2 6 4 を備えてもよい（図 1 0 参照）。センサ 2 6 4 は、任意の形式のセンサとすることができ、たとえば光学式などの測距センサとすることができ。また、センサ 2 6 4 は、研磨テーブル 3 5 0 に設けられてもよい。一例として、センサ 2 6 4 は研磨テーブル 3 5 0 下部に設けられ、研磨テーブル 3 5 0 と研磨パッド 3 5 2 とには、センサ 2 6 4 のセンシング光が通過可能な開口が形成されてもよい。この場合には、研磨テーブル 3 5 0 と研磨パッド 3 5 2 との開口に、センシング光が通過可能な窓部材が配置されてもよい。窓部材は、光透過性を有する素材、具体的には透明な素材（例えば透明プラスチックや透明ガラス等）からなる光透過部材によって構成されて得る。窓部材を配置することにより、センサ 2 6 4 に純水または研磨液などがかかることを防止できる。なお、基板 W F の厚み情報を取得するために、トップリング 3 0 2 または基板 W F と研磨パッド 3 5 2 とを接触させるときには、トップリング 3 0 2 と研磨パッド 3 5 2 とが回転していない状態でトップリング 3 0 2 と研磨パッド 3 5 2 とが接触されることが好ましい。

【 0 0 5 3 】

< 取得ステップ 4 >

ユーザーが基板 W F の厚み情報を予め認識しているような場合には、外部入力によって制御装置 9 0 0 の記憶装置 9 0 0 a に厚み情報が格納されてもよい。こうした場合には、制御装置 9 0 0 は、記憶装置 9 0 0 a に格納された基板 W F の厚み情報を読み取ることにより、基板 W F の厚み情報を取得することができる。また、一例として、複数の同様の基板 W F が続けて基板研磨装置 1 0 0 0 に投入されるような場合には、1 枚または数枚の基

板 W F の厚み情報が取得され、その後の基板 W F については、先に取得された厚み情報が利用されてもよい。

【 0 0 5 4 】

< 位置調整ステップ >

制御装置 9 0 0 は、基板 W F の厚み情報を取得すると、取得した厚み情報に基づいて研磨テーブル 3 5 0 に対するトップリング 3 0 2 の高さ位置を算出する (S 1 4)。具体的な一例として、制御装置 9 0 0 は、研磨パッド 3 5 2 の表面の高さから研磨前のトップリング 3 0 2 の最適な位置を算出するとよい。トップリング 3 0 2 の最適な位置は、基板 W F の厚み情報に基づいて、トップリング本体 2 と弾性膜 (メンブレン) 4 との間の隙間として定義されるメンブレンハイトが、予め定められた所望の範囲内となるように定められるとよい。基板 W F の厚みを考慮することなく、トップリング 3 0 2 の研磨パッド 3 5 2 に対する位置を調整した場合、基板 W F の厚みが大きいときには基板 W F と研磨パッド 3 5 2 との距離 (メンブレンハイト M H) が小さくなり、基板 W F の厚みが小さいときには基板 W F と研磨パッド 3 5 2 との距離が大きくなる。このため、本実施形態では、制御装置 9 0 0 は、基板 W F の厚み情報に基づいてトップリング 3 0 2 の高さ位置を算出する。具体的には、基板 W F の厚みが大きいほどトップリング本体 2 と研磨パッド 3 5 2 との距離が大きく、基板 W F の厚みが小さいほどトップリング本体 2 と研磨パッド 3 5 2 との距離が小さくなるように、トップリング 3 0 2 の高さ位置を算出するものとする。図 1 2 は、一実施形態による、基板の厚みが比較的小さい場合のトップリングと研磨パッドとを示す断面図であり、図 1 3 は、一実施形態による、基板の厚みが比較的大きい場合のトップリングと研磨パッドとを示す断面図である。図 1 2 および図 1 3 に示すように、制御装置 9 0 0 は、基板 W F の厚み情報を考慮して、メンブレンハイト M H が略一定の範囲に収まるように、トップリング 3 0 2 の高さ位置を算出するとよい。

10

20

【 0 0 5 5 】

再び図 1 1 を参照し、続いて、制御装置 9 0 0 は、算出したトップリングの高さ位置となるように、研磨テーブル 3 5 0 に対するトップリング 3 0 2 の高さ位置を調整する (ステップ S 1 6)。そして、制御装置 9 0 0 は、トップリング 3 0 2 と研磨テーブル 3 5 0 との回転を伴って、研磨テーブル 3 5 0 およびトップリング 3 0 2 を回転させながら、基板 W F を研磨パッド 3 5 2 に押し当てて基板 W F を研磨する (ステップ S 1 8)。

30

【 0 0 5 6 】

なお、制御装置 9 0 0 は、基板 W F を研磨ユニット 3 0 0 A , 3 0 0 B の一方のみで研磨するものとしてもよいし、同一の基板 W F を研磨ユニット 3 0 0 A と研磨ユニット 3 0 0 B とで 2 段研磨してもよい。基板 W F を 2 段研磨する場合には、研磨ユニット 3 0 0 B での基板 W F の研磨処理において、研磨ユニット 3 0 0 A での基板 W F の研磨前に取得された基板 W F の厚み情報と、研磨ユニット 3 0 0 A での基板 W F の研磨量とに基づいて、あるいは研磨ユニット 3 0 0 B での基板 W F の研磨前に搬送ユニット 2 0 0 B 内で取得された基板 W F の厚み情報に基づいて、研磨ユニット 3 0 0 B の研磨テーブル 3 5 0 に対するトップリング 3 0 2 の高さ位置が調整されるものとしてもよい。こうすれば、2 段階目の研磨である研磨ユニット 3 0 0 B での研磨においても、トップリング 3 0 2 の位置を適切な位置に調整して処理を行うことができる。なお、研磨ユニット 3 0 0 A での研磨量は、一例として、シミュレーションなどによって予め定められた数値を用いてもよいし、研磨ユニット 3 0 0 A での研磨に要した時間、弾性膜 4 への圧力流体の量などに基づいて算出されるものとしてもよい。

40

【 0 0 5 7 】

研磨ユニット 3 0 0 での基板 W F の研磨が終了すると、アーム 3 6 0 を揺動させて、基板 W F を保持するトップリング 3 0 2 を搬送ユニット 2 0 0 の基板受け渡し位置まで移動させる。その後、トップリング 3 0 2 の真空吸着を開放し、基板 W F を第 2 ステージ 2 7 0 の支持柱 2 7 2 に支持させる。その後、プッシャ 2 3 0 を下降させて、基板 W F を搬送ローラ 2 0 2 上に受け渡す (図 6 参照)。

50

【 0 0 5 8 】

なお、研磨ユニット 3 0 0 で基板 W F の研磨が終了すると、研磨ユニット 3 0 0 では、ドレッシングユニット 3 5 6 およびアトマイザ 3 5 8 などを用いて研磨パッド 3 5 2 のドレッシング、洗浄などが行われる。このときには、上記したようにドレッサ 5 0 を利用して研磨パッド 3 5 2 の摩耗量が測定されるとよい。また、制御装置 9 0 0 は、連続する新たな基板研磨処理について、トップリング 3 0 2 の高さ位置を調整する際には（図 1 1 : S 1 4 , S 1 6 ）、研磨パッド 3 5 2 の摩耗量分を補正するようにしてもよい。一例として、制御装置 9 0 0 は、連続する新たな基板 W F の研磨処理について、トップリング 3 0 2 の高さ位置を、前に測定された研磨パッド 3 5 2 の摩耗量に相当する距離だけ低くなるように算出するものとしてもよい。なお、研磨ユニット 3 0 0 では、1 枚の基板 W F の研磨処理が行われる毎に研磨パッド 3 5 2 のドレッシング、洗浄が行われるものとしてもよいし、複数枚の基板 W F の研磨処理が行われる毎に研磨パッド 3 5 2 のドレッシング、洗浄が行われるものとしてもよい。また、制御装置 9 0 0 は、ドレッサ 5 0 を利用して測定される研磨パッド 3 5 2 の摩耗量に基づいて、または研磨レシピによって予め定められた研磨パッド 3 5 2 の摩耗量に基づいて、1 枚の基板 W F を研磨処理したときの研磨パッド 3 5 2 の摩耗量を推定してもよいし、現在の研磨パッド 3 5 2 の摩耗量を推定してもよい。また、制御装置 9 0 0 は、一例として、過去のデータを蓄積して平均化することで、1 枚の基板 W F を研磨処理したときの研磨パッド 3 5 2 の摩耗量を推定してもよい。そして、制御装置 9 0 0 は、トップリング 3 0 2 の高さ位置を調整する際には（図 1 1 : S 1 4 , S 1 6 ）、推定された研磨パッド 3 5 2 の摩耗量に基づいて高さ位置を補正するものとしてもよい。

【 0 0 5 9 】

研磨ユニット 3 0 0 から搬送ユニット 2 0 0 に基板 W F が受け渡されると、搬送ローラ 2 0 2 を再び始動して基板 W F を搬送する。基板 W F の洗浄をするときは、搬送ローラ 2 0 2 の回転速度を洗浄用の速度に変更してもよい。搬送ローラ 2 0 2 で基板 W F を搬送しながら、上洗浄ノズル 2 8 4 a および下洗浄ノズル 2 8 4 b から洗浄液を基板 W F に向けて噴射して基板 W F を洗浄する。

【 0 0 6 0 】

そして、基板 W F は、搬送ユニット 2 0 0 から乾燥ユニット 5 0 0 に搬送されて乾燥され、その後、アンロードユニット 6 0 0 に搬送する。アンロードユニット 6 0 0 に搬送された基板 W F は、搬送ローラ 2 0 2 により出口まで搬送され、基板研磨装置 1 0 0 0 の外へ搬送される。

【 0 0 6 1 】

以上説明した基板処理方法においては、基板 W F の厚み情報が取得され、取得した基板 W F の厚み情報に基づいて研磨テーブル 3 5 0 に対するトップリング 3 0 2 の位置が調整されて、基板 W F の研磨が行われる。これにより、様々な寸法の基板 W F に対応して適切な研磨処理を行うことができる。

【 0 0 6 2 】

上記した基板処理方法は、基板 W F がアンロードユニット 6 0 0 から排出されることなく、つまり搬送ユニット 2 0 0 を含む処理ラインから排出されることなく、行われることが好ましい。こうすれば、基板研磨処理に要する時間の短縮を図ることができる。

【 0 0 6 3 】

本発明は、以下の形態としても記載することができる。

[形態 1] 形態 1 によれば、研磨面を有した研磨テーブルと、基板を保持して前記研磨面に押圧するためのトップリングと、前記トップリングを上下動させる上下動機構と、基板の厚みに関する情報を取得するためのセンサと、を備えた研磨装置による基板研磨方法が提案される。前記トップリングは、圧力流体が供給される圧力室を形成する弾性膜であるメンブレンと当該メンブレンを保持するトップリング本体とを有し、前記圧力室に圧力流体を供給することで前記基板を前記研磨面に押圧するように構成される。前記基板研磨方法は、前記センサにより前記基板の厚みに関する情報を取得する取得ステップと、取得し

た前記基板の厚みに関する情報に基づいて前記研磨テーブルに対する前記トップリングの高さ位置を調整する位置調整ステップと、前記圧力室に圧力流体を供給して前記基板を前記研磨面に押圧することにより、前記基板を研磨する研磨ステップと、を含む。

形態 1 によれば、基板の厚みに基づいて研磨テーブルに対するトップリングの高さ位置調整することにより、様々な寸法の基板に対応して研磨を行うことができる。

【 0 0 6 4 】

〔形態 2〕形態 2 によれば、形態 1 において、前記取得ステップは、前記基板を保持した前記トップリングと前記研磨テーブルとを接触させることによって行われる。

【 0 0 6 5 】

〔形態 3〕形態 3 によれば、形態 2 において、前記研磨装置は、前記研磨テーブルを回転させるための研磨テーブル回転機構を備え、前記取得ステップは、前記研磨テーブルが回転していない状態で行われる。

【 0 0 6 6 】

〔形態 4〕形態 4 によれば、形態 1 において、前記研磨装置は、前記基板を前記トップリングとの間で受け渡しするプッシャを備え、前記取得ステップは、前記プッシャから前記トップリングに前記基板が受け渡されるときに行われる。

【 0 0 6 7 】

〔形態 5〕形態 5 によれば、形態 4 において、前記取得ステップは、前記プッシャが前記基板を前記トップリングに受け渡すために移動させた距離に基づいて前記基板の厚みに関する情報を取得する。

【 0 0 6 8 】

〔形態 6〕形態 6 によれば、形態 1 において、前記研磨装置は、前記基板を搬送するための搬送ユニットを備え、前記取得ステップは、前記搬送ユニットに設けられたセンサによって前記基板の厚みに関する情報を取得する。

【 0 0 6 9 】

〔形態 7〕形態 7 によれば、形態 1 から 6 において、前記研磨装置は、前記基板を搬送するための搬送ユニットを有する処理ラインを備え、前記取得ステップ、前記位置調整ステップ、および前記研磨ステップは、前記処理ラインから前記基板を搬出することなく行われる。

【 0 0 7 0 】

〔形態 8〕形態 8 によれば、形態 1 において、前記取得ステップは、前記研磨装置への外部入力により行われる。

【 0 0 7 1 】

〔形態 9〕形態 9 によれば、形態 1 から 6 において、前記研磨ステップの後に、前記取得ステップで取得した前記基板の厚みに関する情報と前記研磨ステップによる前記基板の研磨量とに基づいて、第 2 の研磨テーブルに対する第 2 のトップリングの高さ位置を調整する第 2 の位置調整ステップと、前記基板を前記第 2 の研磨テーブルの研磨面に押圧することにより前記基板を研磨する第 2 の研磨ステップと、を含む。

【 0 0 7 2 】

〔形態 10〕形態 10 によれば、基板の処理面に研磨処理を行う制御処理を、研磨装置の処理装置に行わせるためのプログラムが提案される。前記研磨装置は、研磨面を有した研磨テーブルと、基板を保持して前記研磨面に押圧するためのトップリングと、前記トップリングを上下動させる上下動機構と、基板の厚みに関する情報を取得するためのセンサと、を備え、前記トップリングは、圧力流体が供給される圧力室を形成する弾性膜であるメンブレンと当該メンブレンを保持するトップリング本体とを有し、前記圧力室に圧力流体を供給することで前記基板を前記研磨面に押圧するように構成される。そして、前記制御処理は、前記センサにより前記基板の厚みに関する情報を取得する取得ステップと、取得した前記基板の厚みに関する情報に基づいて前記研磨テーブルに対する前記トップリングの高さ位置を調整する位置調整ステップと、前記圧力室に圧力流体を供給して前記基板を前記研磨面に押圧することにより、前記基板を研磨する研磨ステップと、を含む。

10

20

30

40

50

形態 10 によれば、基板の厚みに基づいて研磨テーブルに対するトップリングの高さ位置調整することにより、様々な寸法の基板に対応して研磨を行うことができる。

【 0 0 7 3 】

[形態 1 1] 形態 1 1 によれば、基板研磨装置が提案され、かかる基板研磨装置は、研磨面を有した研磨テーブルと、基板を保持して前記研磨面に押圧するためのトップリングであって、圧力流体が供給される圧力室を形成する弾性膜であるメンブレンと、当該メンブレンを保持するトップリング本体と、を有し、前記圧力室に圧力流体を供給することで前記基板を前記研磨面に押圧するように構成されたトップリングと、前記トップリングを上下動させる上下動機構と、基板の厚みに関する情報を取得するためのセンサと、前記センサにより取得された前記基板の厚みに関する情報に基づいて前記研磨テーブルに対する前記トップリングの高さ位置を調整し、前記圧力室に圧力流体を供給して前記基板を前記研磨面に押圧することにより前記基板を研磨するように構成された制御装置と、を備える。

10

形態 1 1 によれば、基板の厚みに基づいて研磨テーブルに対するトップリングの高さ位置調整することにより、様々な寸法の基板に対応して研磨を行うことができる。

【 0 0 7 4 】

以上、本発明の実施の形態について説明してきたが、上記した発明の実施の形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定するものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得るとともに、本発明にはその均等物が含まれることはもちろんである。また、上述した課題の少なくとも一部を解決できる範囲、または、効果の少なくとも一部を奏する範囲において、実施形態および変形例の任意の組み合わせが可能であり、特許請求の範囲および明細書に記載された各構成要素の任意の組み合わせ、または、省略が可能である。

20

【 符号の説明 】

【 0 0 7 5 】

3 ... リテーナ部材
 1 0 0 ... ロードユニット
 2 0 0 ... 搬送ユニット
 2 3 0 ... プッシャ
 2 3 1 ... 第 1 昇降機構
 2 3 2 ... 第 1 ステージ
 2 3 3 ... 第 2 昇降機構
 2 6 0 ... センサ
 2 6 2 ... センサ
 2 6 4 ... センサ
 2 7 0 ... 第 2 ステージ
 2 7 2 ... 支持柱
 3 0 0 ... 研磨ユニット
 3 0 2 ... トップリング
 3 5 0 ... 研磨テーブル
 3 5 2 ... 研磨パッド
 5 0 0 ... 乾燥ユニット
 6 0 0 ... アンロードユニット
 9 0 0 ... 制御装置
 9 0 0 a ... 記憶装置
 1 0 0 0 ... 基板研磨装置
 W F ... 基板

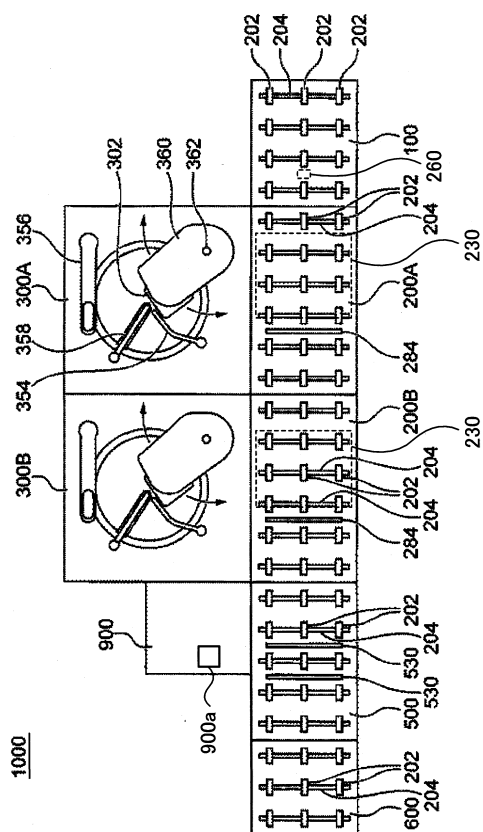
30

40

50

【図面】

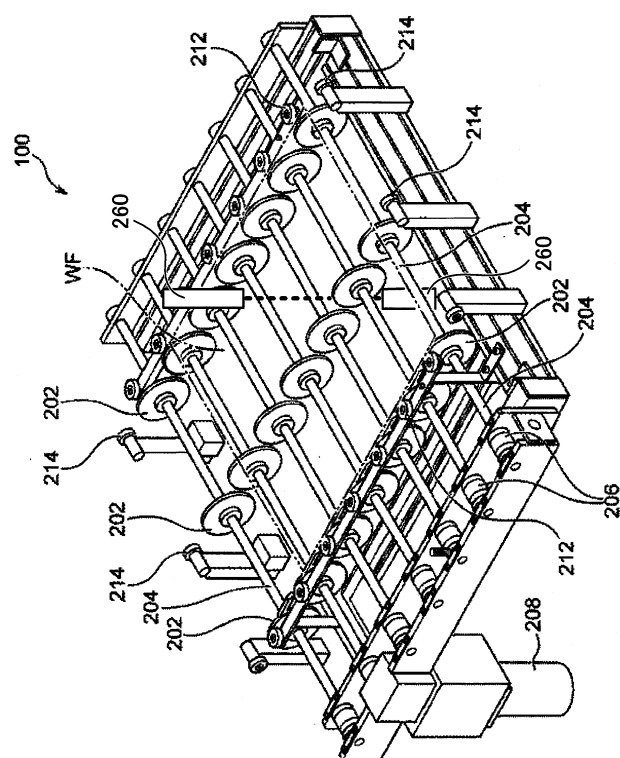
【 図 1 】



10

20

【 図 3 】

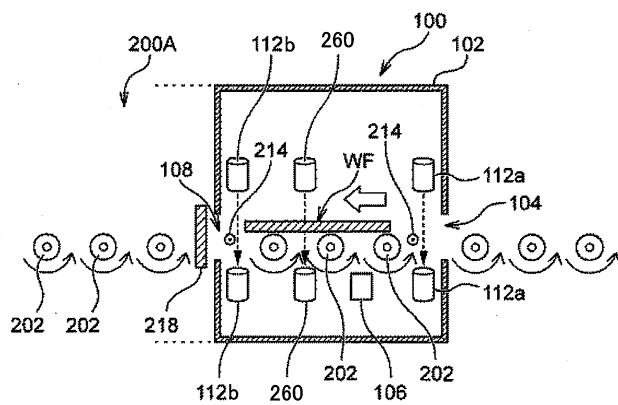


30

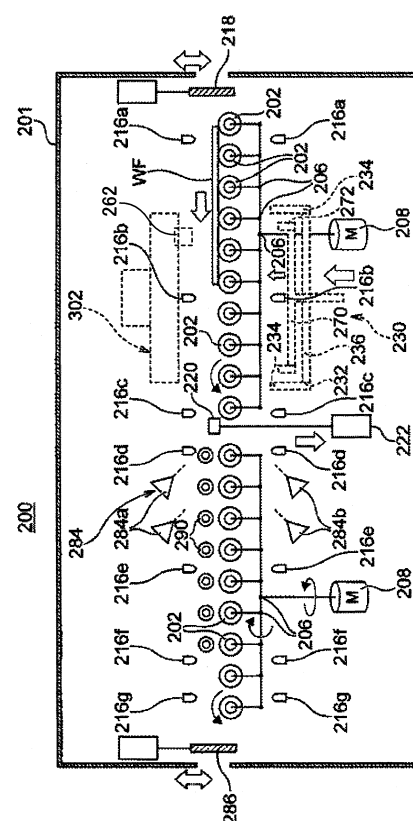
40

50

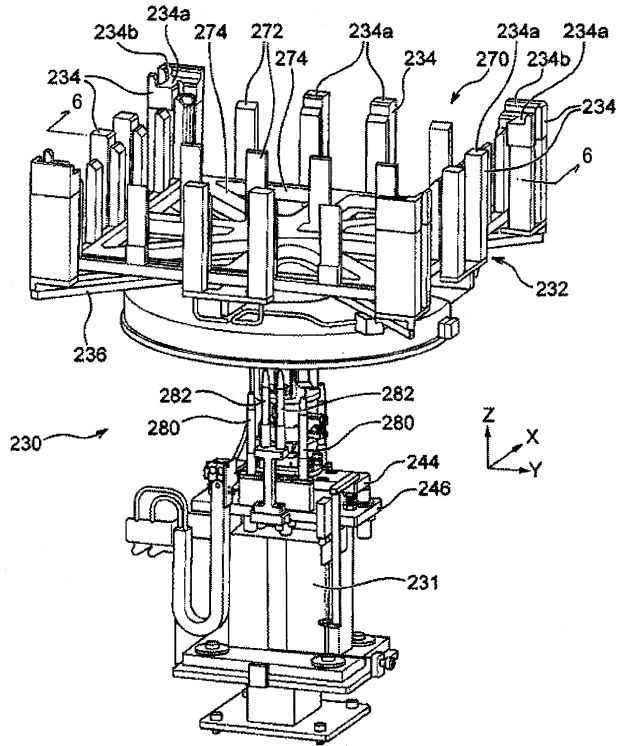
【 図 2 】



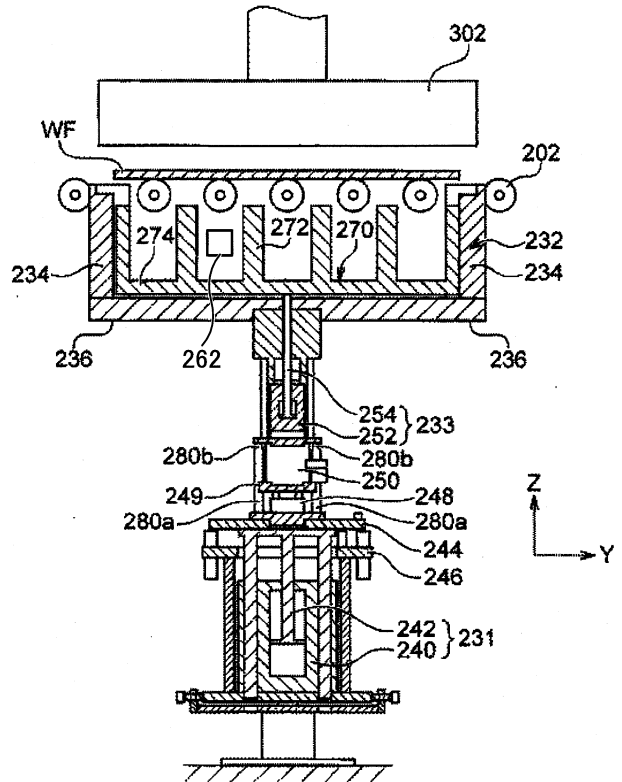
【 図 4 】



【 図 5 】



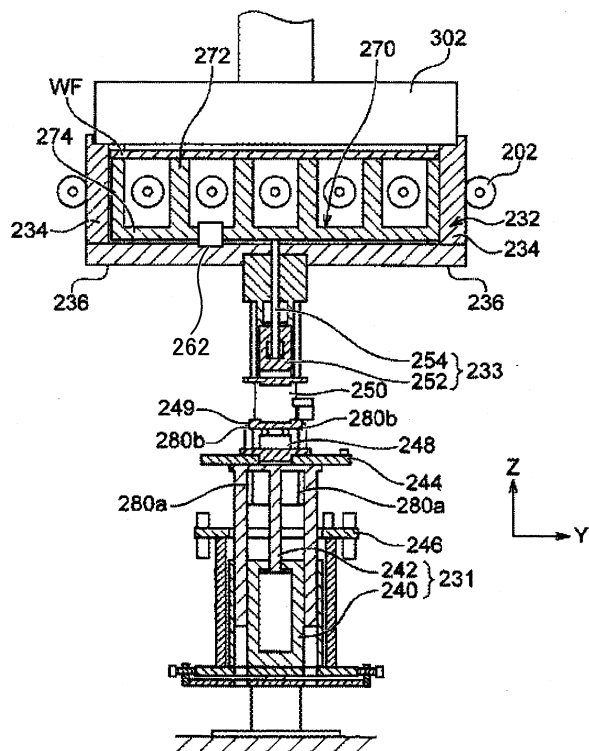
【 図 6 】



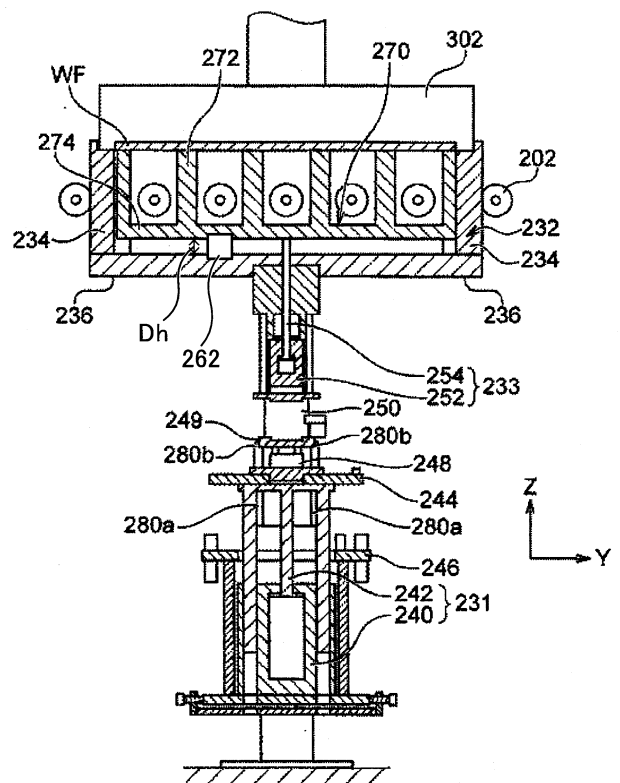
10

20

【 図 7 】



【 図 8 】

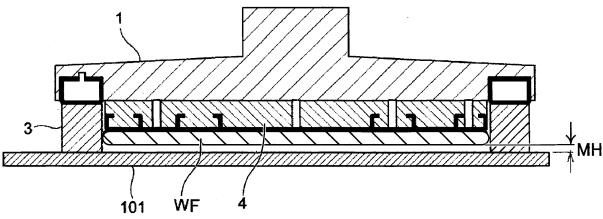


30

40

50

【 図 13 】



10

20

30

40

50

フロントページの続き

(51)国際特許分類	F I	テーマコード (参考)
B 2 4 B 47/22 (2006.01)	B 2 4 B 47/22	
H 0 1 L 21/304 (2006.01)	H 0 1 L 21/304 6 2 2 K	

F ターム (参考)	CA04 CA22 CB08 CB14 DD10
3C158	AA07 AB03 AC02 AC04 BA07 BB02 BB06 BB08 BC01 BC02 CB01 CB03 DA12 DA17 EA11 EA13 EA14 EA23 EB01
5F057	AA24 AA32 CA12 DA03 EC10 FA20 GB02 GB13